

9097250 TOSHIBA (DISCRETE/OPTO)

39C 01920 0 T-31-23



SEMICONDUCTOR

TECHNICAL DATA

東芝トランジスタ TOSHIBA TRANSISTOR

2SC2036

SILICON NPN EPITAXIAL TYPE(PCT PROCESS)★

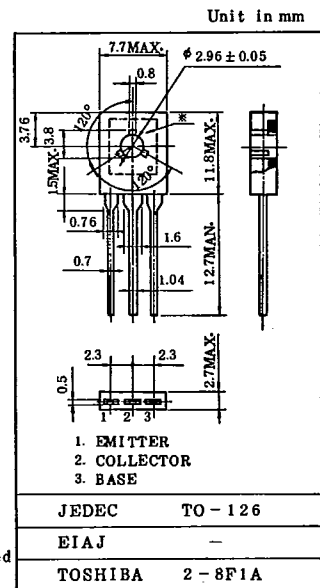
- 27MHz 高周波電力増幅用
- 27MHz RF Power Amplifier Applications
- 1Wトランシーバ送信部出力用および4Wトランシーバ
励振用として適しています。
- Recommended for 1W Mobile Radio Output
Stage and Driver Stage of 4W Transmitter

最大定格 MAXIMUM RATINGS ($T_a=25^\circ\text{C}$)

CHARACTERISTIC	SYMBOL	RATING	UNIT
コレクタ・ベース間電圧	V_{CB0}	80	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CER}	80	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	5	V
コレクタ電流	I_C	1	A
エミッタ電流	I_E	-1	A
コレクタ損失	P_C	1	W
接合温度	T_j	150	$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{stg}	-55~150	$^\circ\text{C}$

注: ※点線内のメタルはコレクタに接続されています。

The inside metal of dotted line is connected to collector lead.

電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_a=25^\circ\text{C}$)

CHARACTERISTIC	SYMBOL	CONDITION	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT
コレクタシャ断電流	I_{CBO}	$V_{CB}=60\text{V}, I_E=0$	—	—	0.1	μA
コレクタシャ断電流	I_{CER}	$V_{CE}=80\text{V}, R_{BE}=220\Omega$	—	—	0.1	mA
エミッタシャ断電流	I_{EBO}	$V_{EB}=5\text{V}, I_C=0$	—	—	0.1	μA
直流電流増幅率	h_{FE}	$V_{CE}=2\text{V}, I_C=150\text{mA}$	100	—	—	—
コレクタ・エミッタ間飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C=500\text{mA}, I_B=20\text{mA}$	—	—	0.7	V
ベース・エミッタ間電圧	V_{BE}	$V_{CE}=2\text{V}, I_C=500\text{mA}$	—	0.9	—	V
トランジション周波数	f_T	$V_{CE}=10\text{V}, I_C=100\text{mA}$	—	150	—	MHz
コレクタ出力容量	C_{ob}	$V_{CB}=10\text{V}, I_E=0, f=1\text{MHz}$	—	12	—	pF

★PCT技術により製造されています。

Produced by Perfect Crystal Device Technology.

TOSHIBA CORPORATION

2SC--02036-1X

105

1661

9097250 TOSHIBA (DISCRETE/OPTO)

39C 01921 D T-31-23

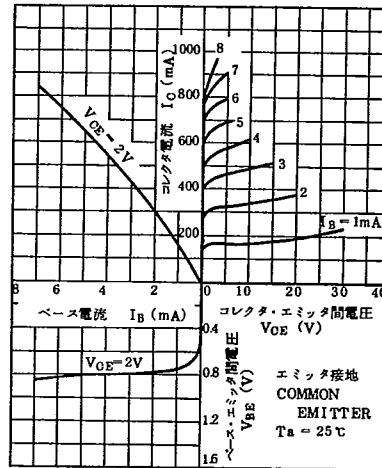


SEMICONDUCTOR

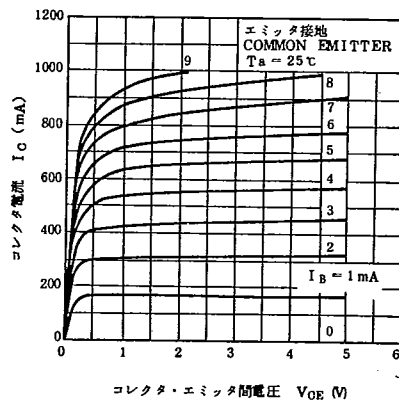
TECHNICAL DATA

2SC2036

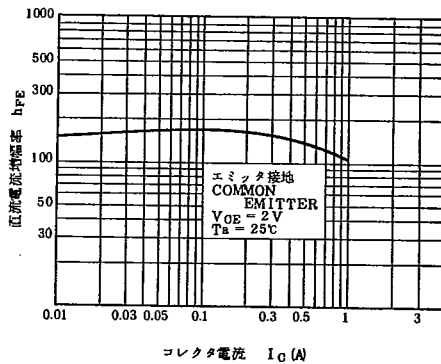
STATIC CHARACTERISTICS



$I_C - V_{CE}$



$h_{FE} - I_C$



106

1662

TOSHIBA CORPORATION

2SC--02036-2X

9097250 TOSHIBA (DISCRETE/OPTO)

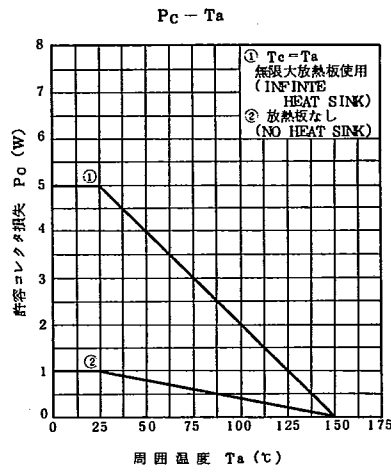
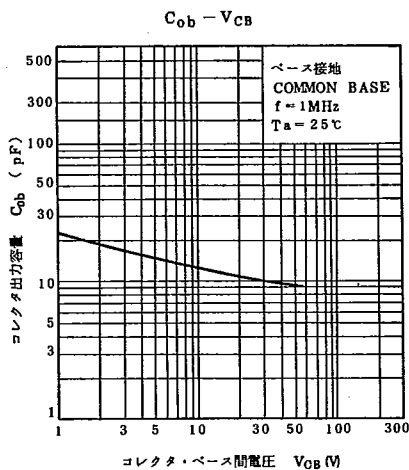
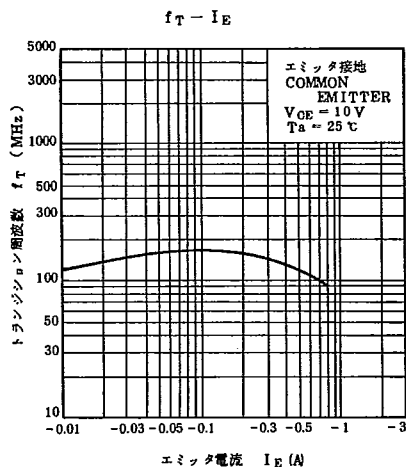
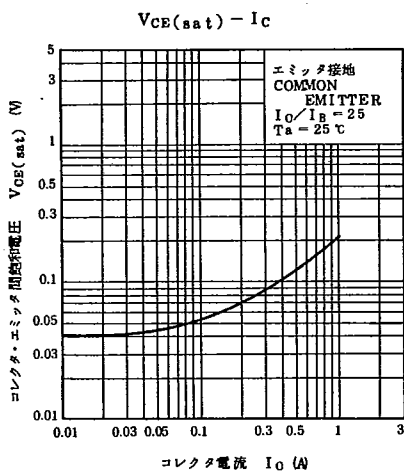
39C 01922 D T-3123



SEMICONDUCTOR

TECHNICAL DATA

2SC2036



TOSHIBA CORPORATION

2SC--02036-3X

107

1663